

型 名	社 名	用 途	構 造	モ ー ド	最 大 定 格					電 気 的 特 性 (Ta=25℃)														
					V*** (V)	区分 ***	VGS* (V)	区分 *	I* (A)	区分 *	Pd/PCh (W)	I _{GSS} (max) (A)	V _{GS} (V)	I _{DSS} (min) (A)	I _{DSS} (max) (A)	V _{DS} (V)	V _{GS(off)} (min) (V)	V _{GS(off)} (max) (V)	V _{DS} (V)	I _D (A)	g _m (typ) (mS)		V _{DS} (V)	I _D (A)
FT6111	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		3	D	36	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	1.2	2.4	10	1.5
FT6111D	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20			D	36	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	1.2	2.4	10	1.5
FT6112	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		4.5	D	40	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	2.5	4.5	10	3
FT6112D	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		4.5	D	40	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	2.5	4.5	10	3
FT6120	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		1.5	D	28	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	0.8	1.3	10	1
FT6120D	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		1.5	D	28	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	0.8	1.3	10	1
FT6121	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		2.5	D	32	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	1.2	2.4	10	1.5
FT6121D	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		2.5	D	32	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	1.2	2.4	10	1.5
FT6122	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		4	D	36	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	2.5	4.5	10	3
FT6122D	富士通	Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		4	D	36	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	2.5	4.5	10	3
FT6211	富士通	Motor-D	MOS	N E	200	DSS	±20		3	D	40	±100n	±20		100μ	200	1.0	2.5	10	1m	1.5	3.5	10	1.5
FT6221	富士通	Motor-D	MOS	N E	200	DSS	±20		2.5	D	36	±100n	±20		100μ	200	1.0	2.5	10	1m	1.5	3.5	10	1.5
FT6240	富士通	HS SW	MOS	N E	200	DSS	±20		5	D	45	±100n	±20		100μ	200	2	4	10	1m	1.5	3.5	10	3
FT6241	富士通	HS SW	MOS	N E	200	DSS	±20		8	D	65	±100n	±20		100μ	200	2	4	10	1m	3	6.5	10	5
FT6260	富士通	HS SW	MOS	N E	200	DSS	±20		7.5	D	55	±100n	±20		100μ	200	2	4	10	1m	3	6.5	10	5
FT6261	富士通	HS SW	MOS	N E	200	DSS	±20		12	D	65	±100n	±20		100μ	200	2	4	10	1m	6	10.5	10	7
FT6540	富士通	HS SW	MOS	N E	500	DSS	±20		4	D	70	±100n	±20		100μ	400	2	4	10	1m	2	3.1	10	2
FT6560	富士通	SW	MOS	N E	500	DSS	±20		3.5	D	60	±100n	±20		100μ	400	2	4	10	1m	2	3.1	10	2
FT6561	富士通	SW	MOS	N E	500	DSS	±20		6.5	D	70	±100n	±20		100μ	400	2	4	10	1m	4	6.6	10	3.5
FT6562	富士通	SW	MOS	N E	500	DSS	±20		8.5	D	75	±100n	±20		100μ	400	2	4	10	1m	6	9.5	10	5
FT6840	富士通	HS SW	MOS	N E	800	DSS	±20		2	D	70	±100n	±20		100μ	640	2	4	10	1m	1	1.7	10	1
FT6860	富士通	SW	MOS	N E	800	DSS	±20		1.8	D	60	±100n	±20		100μ	640	2	4	10	1m	1	1.7	10	1
FT6861	富士通	SW	MOS	N E	800	DSS	±20		3	D	70	±100n	±20		100μ	640	2	4	10	1m	2.5	3.8	10	2
FT6862	富士通	SW	MOS	N E	800	DSS	±20		4.5	D	75	±100n	±20		100μ	640	2	4	10	1m	4	6.2	10	3
FTR6120/6120D	富士通	Head/Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		1.5	D	28	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	0.8	1.3	10	1
FTR6121/6121D	富士通	Head/Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		2.5	D	32	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	1.2	2.4	10	1.5
FTR6122/6122D	富士通	Head/Motor-D	MOS	N E	120	DSS	±20		4	D	36	±100n	±20		100μ	120	0.9	1.7	10	1m	2.5	4.5	10	3
KGF1800	冲	X~K-Band LN A	GaAsHEMT	N D	5	DSX	-3 O		80m	D	200m	-100μ	-2		80m	2	-0.2	-1.5	2	100μ	30m	60m	2	8m
KGF1801	冲	X~K-Band LN A	GaAsHEMT	N D	5	DSX	-3 O		80m	D	200m	-100μ	-2		80m	2	-0.2	-1.5	2	100μ	30m	60m	2	8m
KGF1850	冲	X~K-Band LN A	GaAsHEMT	N D	4	DSX	-3 O		100m	D	200m	-100μ	-2		100m	2		-2	2	100μ	50m	70m	2	15m

電 気 的 特 性 (Ta=25℃)													コンプリ メンタリ	外 形	備 考	型 名
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	V _{GS} (V)	V _{DS} (V)	NF typ dB	NF max dB	f (Hz)	R _G (Ω)	R _{DS(ON)} (max) (Ω)	V _{GS} (V)	I _D (A)	そ の 他 特 性	測 定 条 件				
280	35	0	25					0.6	10	1.5	ton=35ns, toff=70nstyp	VDD=60V, ID=1.5A		247B	2SK × 4	FT6111
280	35	0	25					0.6	10	1.5	ton=35ns, toff=70nstyp	VDD=60V, ID=1.5A		247A	2SK × 4	FT6111D
450	60	0	25					0.4	10	3	ton=55ns, toff=110nstyp	VDD=60V, ID=3A		247B	2SK × 4	FT6112
450	60	0	25					0.4	10	3	ton=55ns, toff=110nstyp	VDD=60V, ID=3A		247A	2SK × 4	FT6112D
130	15	0	25					1.3	10	1	ton=30ns, toff=50nstyp	VDD=60V, ID=1A		248B	2SK × 4	FT6120
130	15	0	25					1.3	10	1	ton=30ns, toff=50nstyp	VDD=60V, ID=1A		248A	2SK × 4	FT6120D
280	35	0	25					0.6	10	1.5	ton=35ns, toff=70nstyp	VDD=60V, ID=1.5A		248B	2SK × 4	FT6121
280	35	0	25					0.6	10	1.5	ton=35ns, toff=70nstyp	VDD=60V, ID=1.5A		248A	2SK × 4	FT6121D
450	60	0	25					0.4	10	3	ton=55ns, toff=110nstyp	VDD=60V, ID=3A		248B	2SK × 4	FT6122
450	60	0	25					0.4	10	3	ton=55ns, toff=110nstyp	VDD=60V, ID=3A		248A	2SK × 4	FT6122D
500	30	0	25					0.8	10	1.5	ton=55ns, toff=115nstyp	VDD=100V, ID=1.5A		247B	2SK × 4	FT6211
500	30	0	25					0.8	10	1.5	ton=55ns, toff=115nstyp	VDD=100V, ID=1.5A		248B	2SK × 4	FT6221
450	20	0	25					0.8	10	3	ton=60ns, toff=100nstyp	VDD=100V, ID=3A		264	GDS	FT6240
800	45	0	25					0.45	10	5	ton=90ns, toff=135nstyp	VDD=100V, ID=5A		264	GDS	FT6241
800	45	0	25					0.45	10	5	ton=90ns, toff=135nstyp	VDD=100V, ID=5A		265	GDS	FT6260
1400	100	0	25					0.25	10	7	ton=130ns, toff=170nstyp	VDD=100V, ID=7A		265	GDS	FT6261
750	45	0	25					2.2	10	2	ton=55ns, toff=110nstyp	VDD=250V, ID=2A		264	GDS	FT6540
750	45	0	25					2.2	10	2	ton=55ns, toff=110nstyp	VDD=250V, ID=2A		265	GDS	FT6560
1800	110	0	25					0.9	10	3.5	ton=90ns, toff=225nstyp	VDD=250V, ID=3.5A		265	GDS	FT6561
2500	170	0	25					0.6	10	5	ton=125ns, toff=300nstyp	VDD=250V, ID=5A		265	GDS	FT6562
500	40	0	25					9	10	1	ton=55ns, toff=130nstyp	VDD=400V, ID=1A		264	GDS	FT6840
500	40	0	25					9	10	1	ton=55ns, toff=130nstyp	VDD=400V, ID=1A		265	GDS	FT6860
1450	90	0	25					3.5	10	2	ton=75ns, toff=195nstyp	VDD=400V, ID=2A		265	GDS	FT6861
1900	140	0	25					2.2	10	3	ton=90ns, toff=310nstyp	VDD=400V, ID=3A		265	GDS	FT6862
130	45	0	25					1.3	10	1	ton=90ns, toff=370nstyp	ID=1A, VDD=60V		248B/A	抵抗入4素子内蔵	FT6120/6120D
280	80	0	25					0.6	10	1.5	ton=115ns, toff=810nstyp	ID=1.5A, VDD=60V		248B/A	抵抗入4素子内蔵	FT6121/6121D
450	150	0	25					0.4	10	3	ton=170ns, toff=1310nstyp	ID=3A, VDD=60V		248B/A	抵抗入4素子内蔵	FT6122/6122D
				1.1	1.3	12G					Ga=10dBtyp	f=12GHz		260	GSD	KGF1800
				1.3	1.5	12G					Ga=10dBtyp	f=12GHz		260	GSD	KGF1801
				0.7	0.9	12G					Ga=10dBmin/10.5dBtyp	f=12GHz		260	GSD	KGF1850